JINGCTECH 晶诚光电股份有限公司
Jing cheng Optoelectronics co.,LTD

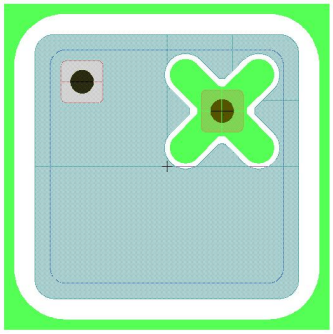
抗辐照光敏三极管芯片 ---CH-034PTN

◆产品特点：

- ●抗辐照
- ●芯片百分百测试分选
- ●高灵敏度、低暗电流

◆应用：

- ●主要应用于电源控制电路、系统装置、测量仪器、 寄存器、各类电器等



◆物理参数：

尺寸

- ●芯片尺寸：34mil × 34mil (850 ± 25 μm × 850 ± 25 μm)
- ●芯片厚度：7.8mil (200 ± 20 μm)

电极材料

- ●正面电极：铝
- ●北面电极：金&银
- ●正面电极尺寸：φ110um

◆光电特性：Tc=22℃

参数	符号		条件	Min	Typ	Max	单位
集电极-发射极	BV_{CEO}		I_{CEO} = 100uA	70	85	160	V
发射极-基极	BV_{ECO}		I_{ECO} = 10uA	7	8.5	10	V
集电极-基极	BV_{CBO}		I_{CBO} = 100uA	100	-	350	V
暗电流	I_{CEO}		V_{CE} = 50V	-	10	60	nA
饱和电压	VCE(Sat)		Ic = 2mA, IB = 10uA	-	–	0.2	V
放大倍数	HFE	C	VCE = 5 V, Ib = 2uA	300	-	800	
		D		700	-	1200	
		E		1100	-	1500	

◆极限参数:

参数	符号	Min	Typ	Max	单位
工作温度	T_{opr}	-55		125	℃
储存温度	T_{stg}	-65	-	125	℃

◆稳态总剂量 150K rad(Si)辐照参数:

参数	符号	测试条件	Min	Typ	Max	单位
集电极暗电流	I_{CEO}	VCE=50V；H=0mW/cm2		10	60	nA
电流增益	H_{FE}	VCE = 5 V, Ib = 2uA	300		1500	

注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 25±5℃，湿度≤45%;
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准;

  本产品说明书如有版本变更，恕不另行通知！请客户下单前向销售人员索取最新版本资料并验证相关